12-18GHz 30dBm GaAs MMIC Driver Amplifier

关键指标

▶ 频率范围: 12GHz~18GHz

▶ 增益: 22dB

輸出 P₋₁dB: 30dBm輸出 IP₃: 40dBm工作电源: +5~+6V

▶ 封装尺寸: 5mm×5mm×1.2mm

典型应用

- ▶ 点对点通信
- ▶ 卫星通信
- ▶ 军事及航天
- 测试测量仪器雷达

产品简介

HX339160F5是一款工作频率为 12~18GHz的驱动放大器,是 HX339160裸芯片的封装型号,该放大器采用 GaAs 工艺制造,封装于 QFN6x6管壳内,可适应回流焊接工艺。

电性能 (T_A=25°C, V_D=+6V, I_D=1000mA, Z₀=50Ω)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率		12~18		GHz
小信号增益	18	22	_	dB
小信号增益平坦度	_	±2.5	_	dB
反向隔离度	_	-65	_	dB
输入回波损耗	_	-14	_	dB
输出 IP ₃	_	40	_	dBm
输出 P₋₁dB	_	30	_	dBm
漏极电压(V _D)	5	_	6	V
工作电流(៤)	_	1000	1700	mA

*测试条件: Pout/Tone=+22 dBm,fc=16GHz, △ f=5MHz

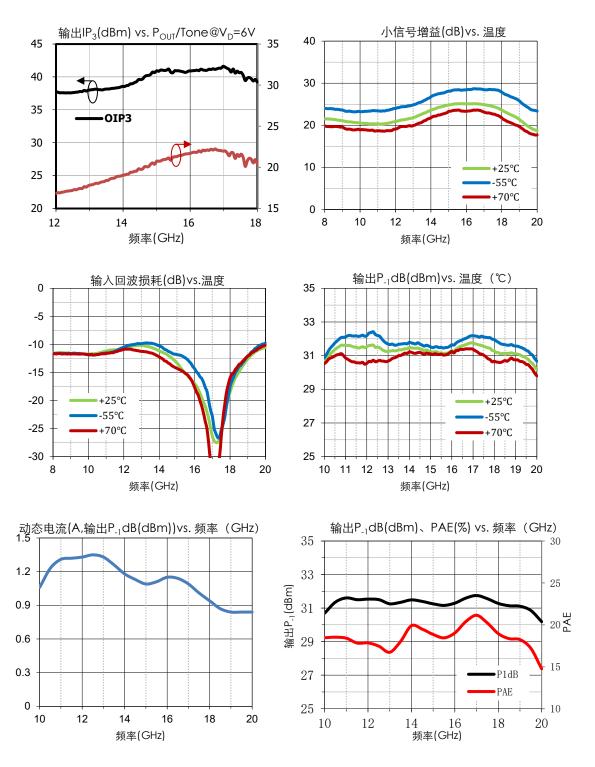
绝对最大额定值

最大输入功率	+13dBm	工作温度	-55℃~+70℃
沟道温度	+150℃	贮存温度	-65℃~+150℃
最大 V _D	+6.5V	最大 V _G	-1.2V

Hisiwell Technology Co.,Ltd Email: Sales@hisiwell.com

典型性能测试曲线

偏置:V_D=6V,I_D=1000mA

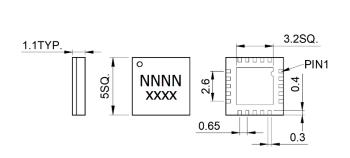


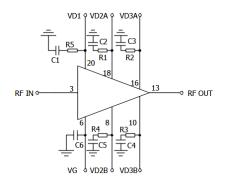
Hisiwell Technology Co.,Ltd Email: Sales@hisiwell.com

12-18GHz 30dBm GaAs MMIC Driver Amplifier

外形尺寸图(mm)

应用电路图





引脚定义

编号	功能	编号	功能	编号	功能
1	接地	8	VD2B	15	接地
2	接地	9	接地	16	VD3A
3	射频输入	10	VD3B	17	接地
4	接地	11	接地	18	VD2A
5	接地	12	接地	19	接地
6	VG	13	射频输出	20	VD1A
7	接地	14	接地		

元件清单

编号	数值	型号	制造商	封装
C6	1uF	GRM155R61A105KE15D	村田	0402
C1~C5	0.47uF	GRM155R61A474KE15D	村田	0402
R1~R5	2R2	-	-	0402

使用说明

- 1. HX339160F5需要两组供电电压,栅极为负电压,漏极为正电压;当漏极电压设置为6V时,建议的栅极电压设置为-0.5~-0.75V;
- 2. 该器件背面为射频接地兼散热,在工艺条件允许的情况下应尽可能增加接地过孔数量。

Hisiwell Technology Co.,Ltd Email: Sales@hisiwell.com